

تعداد سوالات: سنتی: ۲۰ تشریحی: ۴
 زمان آزمون: سنتی: ۶۰ دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: فیزیک حالت جامد ۲

رشته تحصیلی و کد درس: فیزیک (جامد) - ۱۱۱۳۰۲۶

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانشها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

الف. مدل الکترون تقریباً آزاد پاسخگوی ایجاد گاف انرژی است.

ب. گافهای انرژی از برهmekش امواج الکترونهای رسانش با مغزهای یونی بلور نتیجه می‌شوند.

ج. علامت ضریب هال را می‌توان از پاسخ الکترونها در بلورها در میدانهای اعمالی توجیه کرد.

د. ساختار نواری بلورها را اغلب می‌توان با مدل الکtron آزاد توصیف کرد.

۲. پهنهای منطقه دوم بریلوئن در یک شبکه خطی با پارامتر a کدام است؟

د. $\frac{4\pi}{a}$

ج. $\frac{2\pi}{a}$

ب. $\frac{\pi}{a}$

الف. $\frac{\pi}{2a}$

۳. چگالی احتمال برای موج ایستاده $\chi(+), \chi(-)$ به ترتیب برابر $\sin^2(\frac{\pi x}{a}), \cos^2(\frac{\pi x}{a})$ می‌باشد. اختلاف انرژی بیناین دو حالت برای یک پتانسیل بلور به صورت $U(x) = U_0 \cos^2(\frac{\pi x}{a})$ کدام است؟

د. $8U$

ج. $4U$

ب. $2U$

الف. U

۴. کدامیک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند مفهوم k را در تابع موج بلوخ توضیح دهد؟الف. k اندازه حرکت الکترون داخل بلور است.ب. تابع $u(r)_k$ به بردار موج k بستگی دارد.ج. $\hbar k$ اندازه حرکت بلوری نامیده می‌شود.

د. معادله ویژه مقداری برای عملگر تکانه نمی‌توان تعریف کرد.

۵. محدوده تقریبی تراکم الکترونهای رسانش بر حسب cm^{-3} نیمه فلزات کدام است؟

الف. $10^{13} - 10^{17}$ ب. $10^{15} - 10^{18}$ ج. $10^{17} - 10^{21}$ د. $10^{21} - 10^{23}$

۶. اگر انرژی الکترونی با بردار موج $E(\vec{k}) \equiv \frac{\hbar^2}{m}(k_x + ik_y)$ باشد. عناصر ماتریسی $(m^*)^{-1}$ کدام است؟

د. $\frac{1}{m} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$

ج. $\frac{1}{m} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

ب. $\frac{1}{m} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

الف. $\frac{1}{m} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

۷. کدام یک از گزینه های زیر در مورد ساختار لبه نوار در نیم رسانای با گاف مستقیم صحیح نیست؟

الف. نوارهای ظرفیت در نزدیکی لبه شامل حفره های سنگین و حفره های سبک است.

ب. نوارهای حفره های سنگین و حفره های سبک در مرکز واگن اند.

ج. نوار مربوط به حفره های شکافتگی در اثر برهمنکش اسپین - مدار از نوارهای حفره های سنگین و سبک جدا می شوند.

د. شیب نوار مربوط به حفره های سبک در نزدیکی مبدأ کمتر از شیب نوار مربوط به حفره های سنگین است.

۸. وابستگی دمایی انرژی تراز فرمی برای یک نیم رسانا با مشخصه $m_e = m_h$ کدام است؟الف. مستقل از دما $T^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\alpha}{T}}$ ب. متناسب با $T^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\alpha}{T}}$

۹. به نسبت مقدار سرعت رانشی به میدان الکتریکی گویند.

الف. توان ترمومتریکی

ب. ضریب پلیتیه

د. تحرک پذیری حامل

ج. ضریب زبک

۱۰. به دوره ای بودن مشخصه ویژگیهای یک فلز در یک میدان مغناطیسی یکنواخت بر حسب $\frac{1}{B}$, می گویند.

الف. اثر دوهاس - وان آلفن

د. اثر تشدید سیکلوترونی

ج. اثر کوهن - هاینه

۱۱. اگر E_F انرژی فرمی الکترون آزاد، ω_c فرکانس سیکلوترون و E_g گاف انرژی باشد، شرط فرو ریزش مغناطیسی کدام است؟الف. $(\hbar\omega_c)^{\frac{3}{2}} > \omega_F E_g$ ب. $\omega_F^{\frac{3}{2}} > E_g (\hbar\omega_c)$ ج. $\hbar\omega_c E_g > \epsilon_F^{\frac{3}{2}}$ د. $\hbar\omega_c \omega_F > E_g^{\frac{3}{2}}$ ۱۲. کدام K های مجاز در منطقه اول بریلوتن کدام است؟ (N تعداد سلولهای اولیه بلور است)الف. $\frac{N}{2}$ ب. $2N$ ج. $\frac{N}{4}$ د. $4N$ ۱۳. تعداد موثر مگنتونهای بور برای یک الکترون دارای $s = \frac{1}{2}$ ، $l = 1$ کدام است؟الف. $\frac{\sqrt{12}}{2} g$ ب. $\frac{3}{2} g$ ج. $\frac{\sqrt{15}}{2} g$ د. $\frac{15}{2} g$

۱۴. کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف. منشاء قاعده اول هوند در اصل طرد و در دافعه کولنی بین الکترونهاست.

ب. قاعده سوم هوند پیامدی از علامت برهمکنش اسپین - مدار است.

ج. پذیرفتاری دیا مغناطیسی در دماهای بالا و میدانهای ضعیف تر متناسب با $\frac{1}{T}$ است.

د. در دماهای پایین و میدانهای مغناطیسی قوی، مغناطش پارامغناطیس به مقدار اشبع می رسد.

۱۵. مطابق با معادله کلاسیکی لانژون وابستگی پذیرفتاری دیا مغناطیسی در واحد حجم با عدد اتمی Z کدام است؟

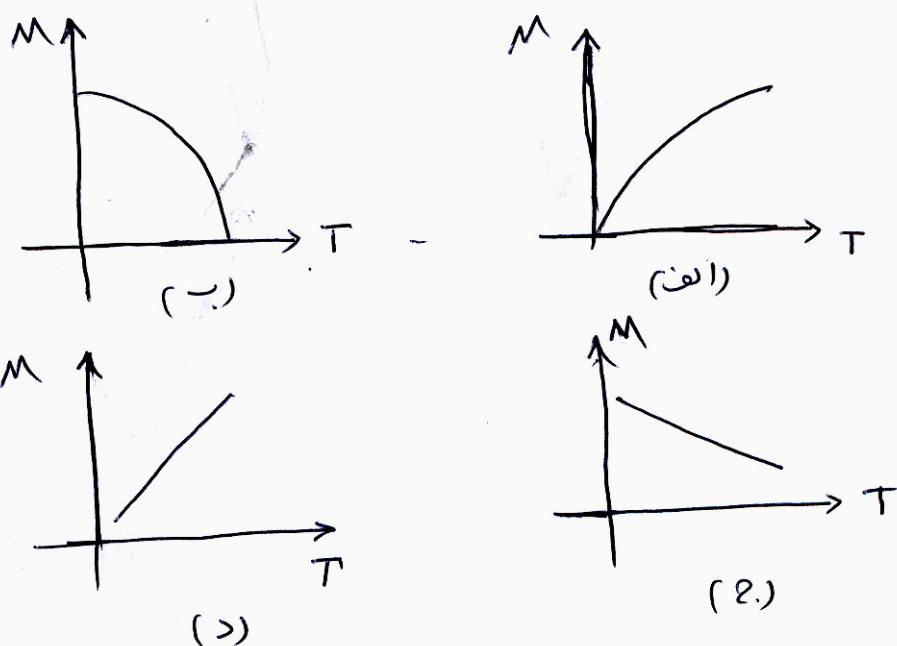
$$\chi \propto Z$$

$$\chi \propto \frac{1}{Z}$$

$$\chi \propto \frac{1}{Z^2}$$

$$\chi \propto Z^3$$

۱۶. کدام یک از منحنیهای زیر، تغییرات دمایی مغناطش را در مواد فرومغناطیسی می دهد؟



۱۷. کدام یک از گزینه های زیر در مورد امواج اسپینی صحیح است؟

الف. در طول موجهای کوتاه ωk

ب. دمای کوری در قانون کوری - وايس، $T_c = c^3 \lambda$ است.

ج. به برانگیختگیهای بنیادی یک دستگاه اسپینی مگنون گویند.

د. انرژی حالت پایه امواج اسپینی برابر $\hbar \omega_k$ می باشد.

۱۸. کدام یک از گزینه های زیر در مورد پراش نوترونها صحیح نیست؟

الف. نوترونها فقط توزیع مغناطیردگی الکترونی را می بینند.

ب. گشتاور مغناطیسی نوترون با گشتاور مغناطیسی الکترون بر همکنش می کند.

ج. در پراکنده گی، ناکشسان یک نوترون می تواند یک مگنون را خلق و یا نابود کند.

د. برای تعیین تجربی طیف مگنون از پرتو نوترونی استفاده می شود.

۱۹. اگر M نماینده یک فلز سه ظرفیتی باشد فرمول عمومی $M_{\mu}Fe_5O_{12}$ بیانگر چه گروهی از مواد مغناطیسی است.

الف. فرو مغناطیسی ها ب. پاوفرو مغناطیسی ها ج. فری مغناطیسی ها د. نارسنگهای آهن

۲۰. در کدام یک از مواد مغناطیسی زیر رفتار پذیرفتاری مغناطیسی در زیر دمای بحرانی آن بی نهایت نیست؟

الف. پارا مغناطیسی ب. فرو مغناطیسی ج. همه مواد مغناطیسی د. پادفرو مغناطیسی

سوالات تشریحی

بارم هر سوال ۱/۷۵ نمره است.

۱. نوارهای انرژی الکترون آزاد را برای یک شبکه بلوری FCC در تقریب شبکه خالی، ولی در نمایش منطقه ای تحويل یافته که در

$k = \frac{2\pi}{a} \left(\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ تا شش برابر انرژی پایین ترین نوار در مرز منطقه یعنی در ΔM نظر بگیرید. انرژی تمام نوارها را در جهت [۱۱۱] تغییرات نسبی مغناطیردگی نشان دهد که تغییرات نسبی مغناطیردگی $\frac{\Delta M}{M(0)}$ متناسب با $T^{\frac{3}{2}}$ است.

بطور تقریبی رسم کنید.

۲. با محاسبه تراکم حاملهای ذاتی n , p بر حسب گاف انرژی نواری E_g در دمای T رابطه تراز مندی موسوم به «قانون اثر جرم» را اثبات نمایید.

۳. با در نظر گرفتن رابطه پاشندگی مگنونها در یک فرومغناطیس در یک بعد و با بر همکنش همسایه های اول (در حد طول موجهای بلند)

نمایش دهد که تغییرات نسبی مغناطیردگی $\frac{\Delta M}{M(0)}$ متناسب با $T^{\frac{3}{2}}$ است.

۴. یک ماده پارا مغناطیس شامل N اتم که با گشتاور دو قطبی مغناطیسی μ غیر بر همکنش با هم را درنظر بگیرید. با اعمال یک میدان مغناطیسی B ترازهای انرژی آن به صورت $J - \bar{\mu} \cdot \vec{B} = m_J g \mu_B B$ تغییر می کند که در آن g ضریب لانده، m_J مگنون بوهر و عدد کوانتمی J بین $-J$ و J تغییر می کند. با محاسبه مغناطیش دستگاه در حد دمایی بالا و پایین پذیرفتاری مغناطیسی را به دست آورید.